Кристаллическое и электронное строение твердых тел

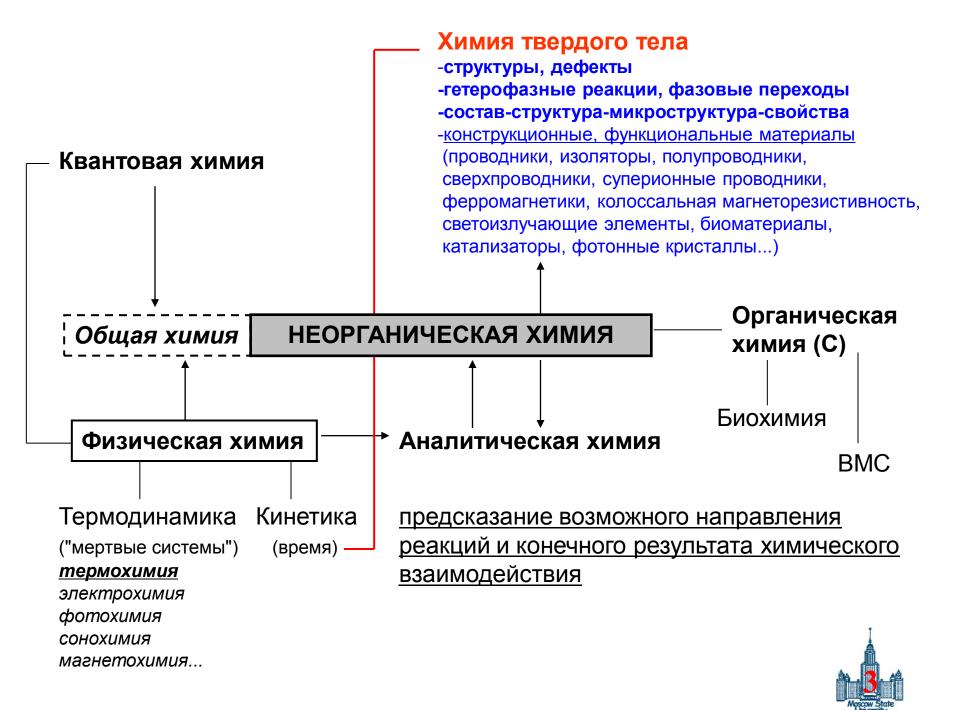


/

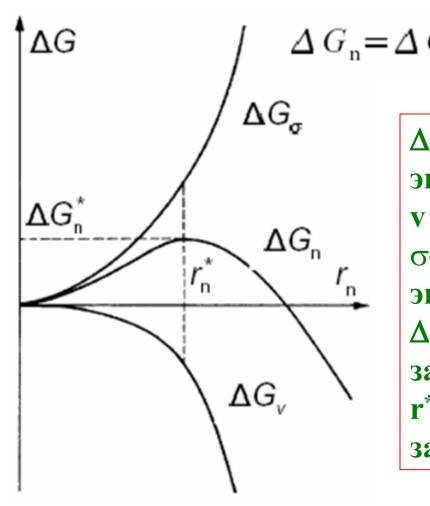
Знания о кристаллическом и электронном строении твердых тел являются принципиально важными для любого грамотного химика, поскольку в современном обществе, в рамках развития научно — технического прогресса создано и функционирует огромное множество твердофазных материалов, составляющих основу для практически всех современных высокотехнологических устройств.

Химия твердого тела — основной междисциплинарный раздел химии, фокусировано изучающий строение, свойства и способы получения твердых тел.





Гомогенное зародышеобразование



 $\Delta G_{n} = \Delta G_{v} + \Delta G_{\sigma} = \frac{4}{3} \pi r_{n}^{3} \Delta g/v + 4 \pi r_{n}^{2} \sigma$

 Δg — разность мольных свободных энергий фаз,

v — молярный объем кристалла, о- удельная поверхностная

энергия

 ΔG_n – энергия образования зародыша,

r*_n – радиус критического зародыша

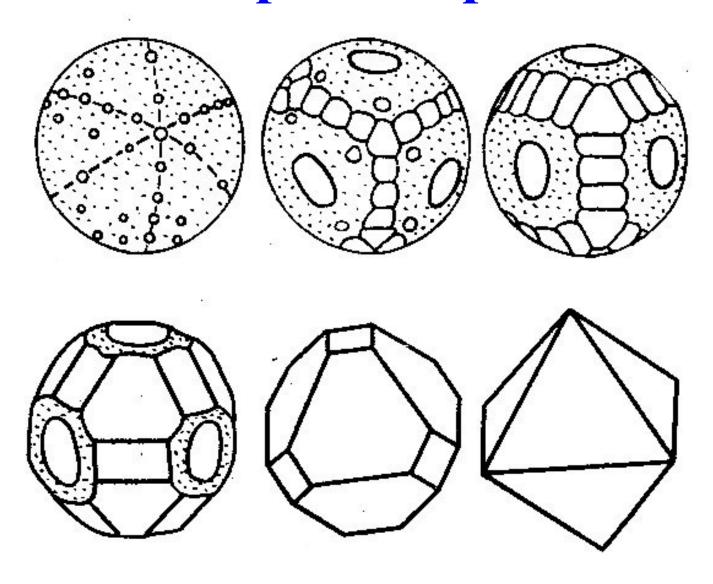




Формирование кристаллических фаз (в общем случае и других тоже) происходит через стадию зародышеобразования и роста зародышей. Теория последующего демонстрирует важность «коллективного поведения» атомов, ионов, молекул при формировании конденсированной фазы. В случае рассматривается объемное состояние ЭТОМ поверхностная энергия фазы или ее зародыша, которые состоят из большого количества отдельных составляющих. В этом - существенное отличие от «классической» химии, которая оперирует отдельными молекулами и атомами, их строением и химическими взаимодействиями.



Самоогранка кристалла





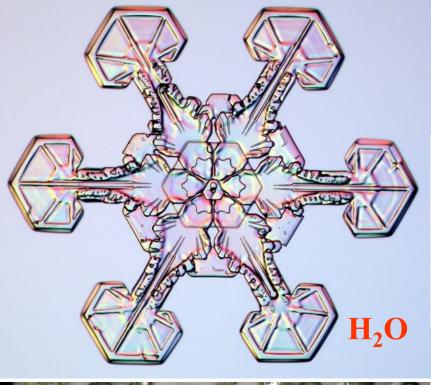
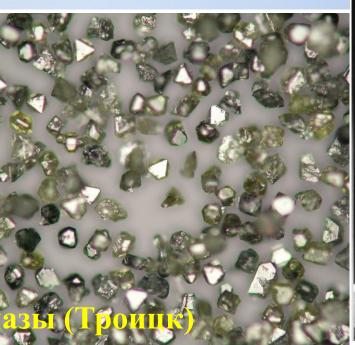






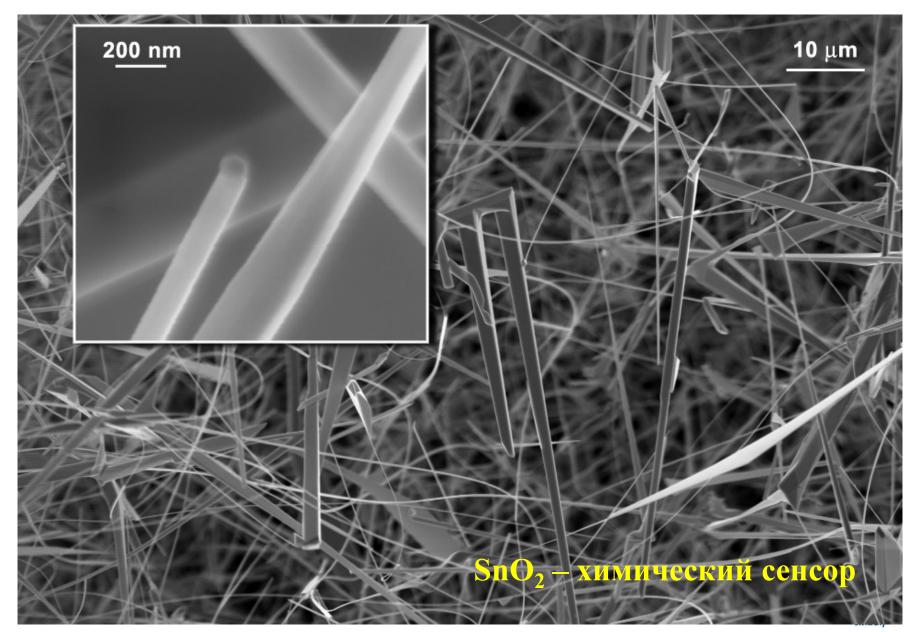
Fig. 17.9. Emerald crystals grown from $\text{Li}_2\text{O-MoO}_3$ flux

Кварц





Вискеры SnO₂





Разнообразие форм кристаллов обусловлено не только их «внутренним», упорядоченным, кристаллическим строением, но и, в немалой степени, особенностями формирования и динамикой роста в разупорядоченной среде (газ, жидкость), в которой они формировались при заданных температуре, давлении, а также в условиях отклонения системы от равновесия, выражаемых, в частности, величиной пересыщения / переохлаждения.



Плотнейшие упаковки

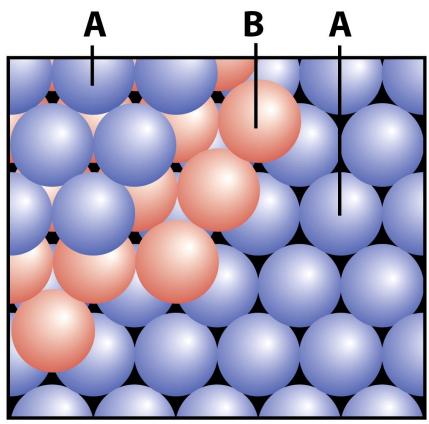


Figure 3-10a
Shriver & Atkins Inorganic Chemistry, Fourth Edition
© 2006 by D.F. Shriver, P.W. Atkins, T.L. Overton, J.P. Rourke, M.T. Weller, and F.A. Armstrong

Последовательность АВАВАВ

ГПУ: гексагональная

плотнейшая упаковка Заполнение пространства 74%

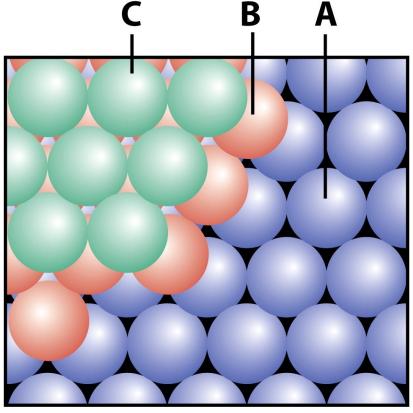


Figure 3-10b

Shriver & Atkins Inorganic Chemistry, Fourth Edition

© 2006 by D.F. Shriver, P. W. Atkins, T. L. Overton, J. P. Rourke, M. T. Weller, and F. A. Armstrong

Последовательность АВСАВС

КПУ: кубическая

плотнейшая упаковка Заполнение пространства 74%

Кристаллические структуры

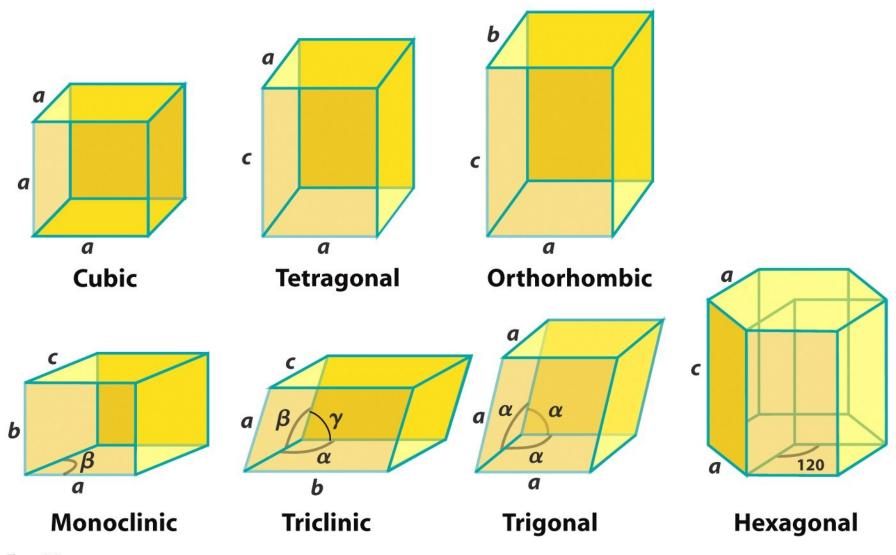
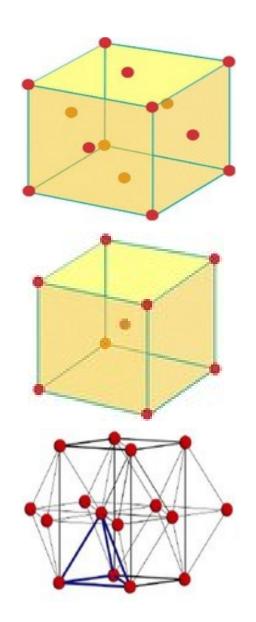


Figure 3-2

Shriver & Atkins Inorganic Chemistry, Fourth Edition

© 2006 by D. F. Shriver, P. W. Atkins, T. L. Overton, J. P. Rourke, M. T. Weller, and F. A. Armstrong

Структуры металлов



1. Структурный тип Си (КПУ), **к.ч. = 12** Ag, Au, Ca, Al, Pb, ...

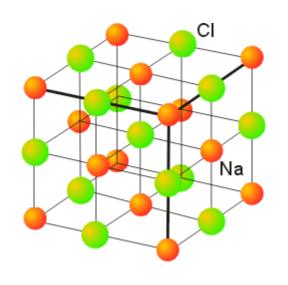
2. Структурный тип α-Fe (ОЦК), к.ч. = 8+6

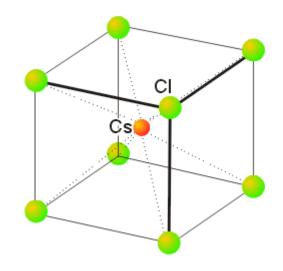
Li, Na, Zr, Cr, Mo, ...

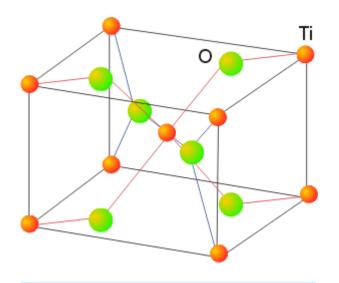
3. Структурный тип Mg (ГПУ), **к.ч. = 12** Be, Ca, Cd, Ti, Co, ...



Основные структурные типы







1. NaCl

галогениды, сульфиды, оксиды и нитриды металлов

KCl, FeO, AgBr, EuS, PbS

2. CsCl

галогениды и халькогениды металлов (большие катионы), сплавы

TlBr, CaSe, AuTi, CuZn, LiPb

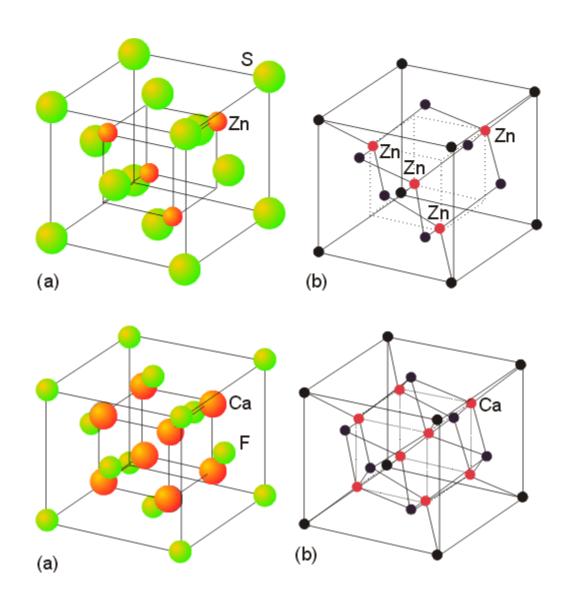
3. TiO₂ (рутил)

оксиды, фториды и нитриды металлов

MgF₂, CoF₂, CrO₂, MnO₂, IrO₂, Ti₂N



Основные структурные типы



4. ZnS (сфалерит)

халькогениды, галогениды и фосфиды металлов

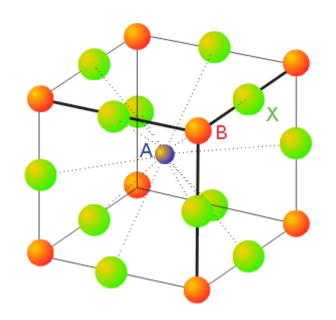
CdTe, GdS, MnSe, AgI, AlP

5. **CaF**₂

фториды, гидриды, оксиды, сплавы

BaF₂, PbO₂, GdH₂, PtAl₂, AuIn₂

Основные структурные типы



6. CaTiO₃ (перовскит)

Самый распространенный структурный тип для тройных соединений

AgCoF₃, TlMnCl₃, BaCeO₃, BaLiH₃

Другие важные структурные типы:

Шпинель $(MgAl_2O_4)$ оксиды и сульфиды

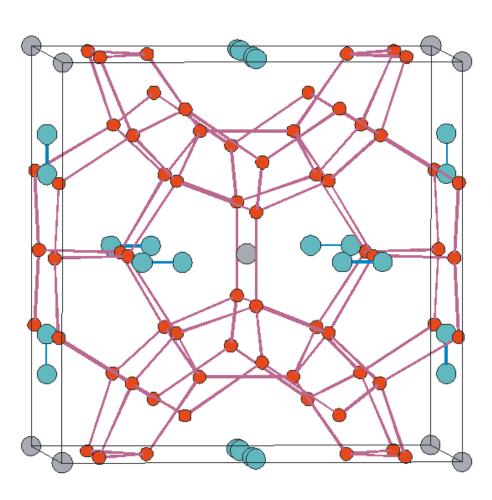
Иодид кадмия (CdI₂) галогениды и халькогениды

Пирит (FeS₂) халькогениды и пниктиды переходных металлов

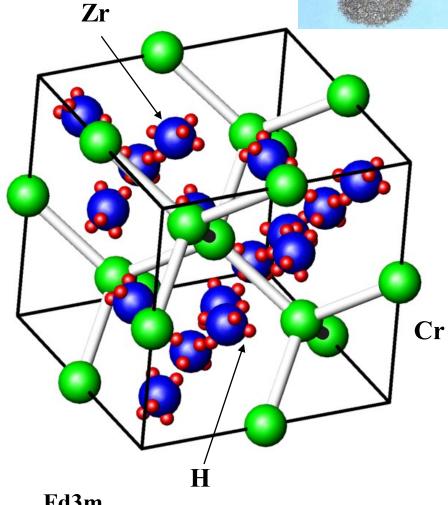
Арсенид никеля (NiAs) пниктиды, халькогениды, сплавы



Интеркаляты



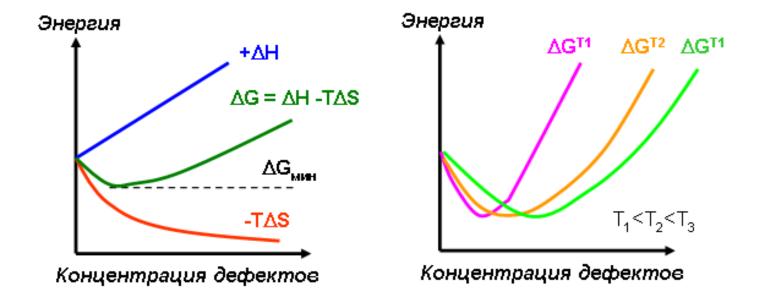
6.5 Cl₂ * 46 H₂O



Fd3m a=4.697Å

ZrCr₂H_{3.5}





$$S = k \ln W$$

Лишь в **гипотетическом**, **абсолютно химически чистом идеальном кристалле** существует бесконечная решетка из строго периодически расположенных в пространстве атомов, которые находятся в покое в своих равновесных положениях (0K).

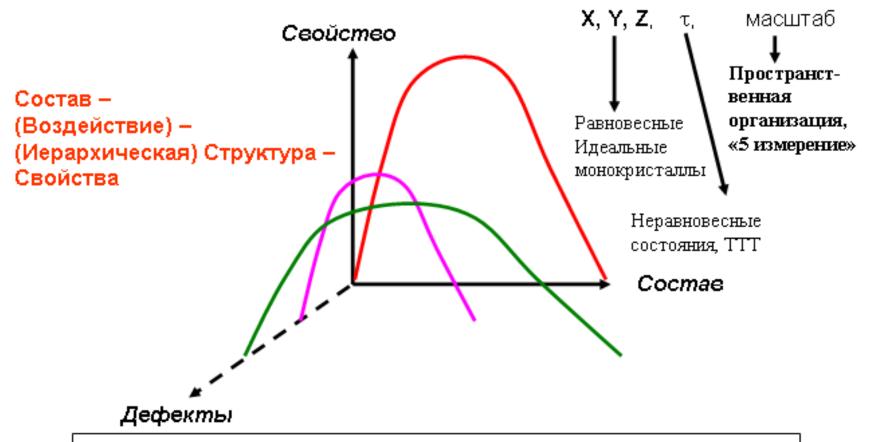
Реальный кристалл ограничен гранями и содержит точечные и протяженные дефекты.

Дефекты (от лат. defectus — недостаток, изъян) – нарушения периодичности кристаллической структуры.

0D, 1D, 2D, 3D дефекты, собственные и примеси, равновесные и неравновесные

"Кристаллы как люди: именно несовершенства делают их интересными" (Colin Humphreys). Большинство свойств материалов определяются дефектами (искусственно введенными: полупроводники, суперионные проводники, ВТСП).

Свойства



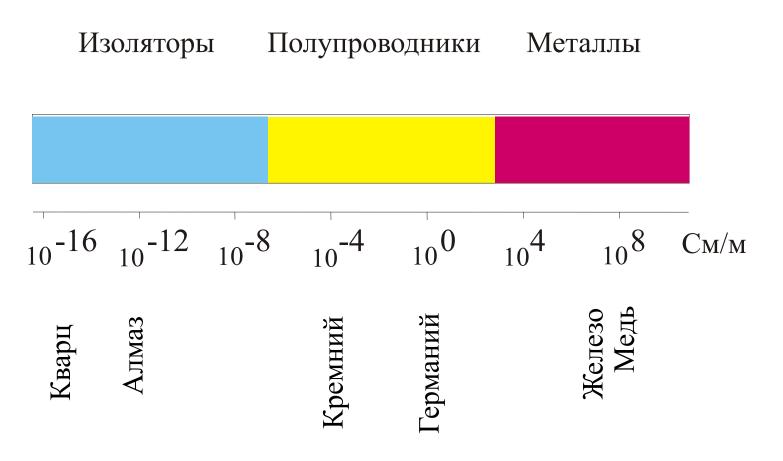


/

Наличие дефектов в твердом теле — их естественная черта, составляющая, которая предопределяет многие физические свойства кристаллических твердых тел. Контроль типа и концентрации дефектов — способ создания материалов с заданными полезными (иногда говорят функциональными) характеристиками. Исследование и использование корреляций типа «состав — структура - свойства» являются ключевыми для химии твердого тела.



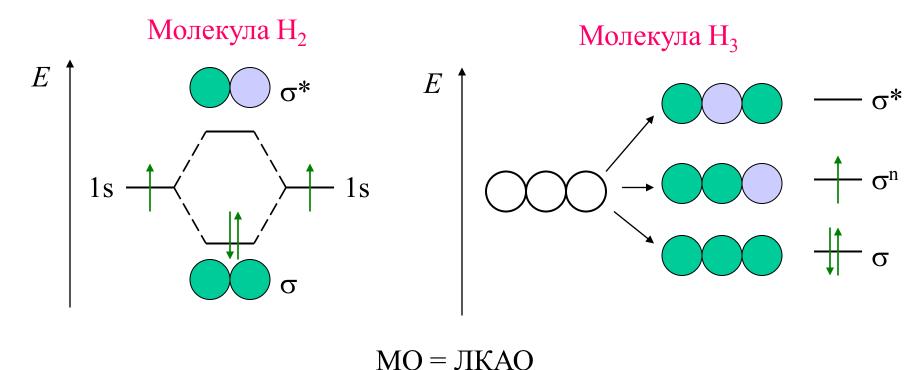
Шкала проводимости





МО молекул H_2 и H_3

От атомных орбиталей к молекулярным орбиталям, от молекулярных орбиталей к «кристаллическим орбиталям»



Принимают участие только s-орбитали



Образование зон

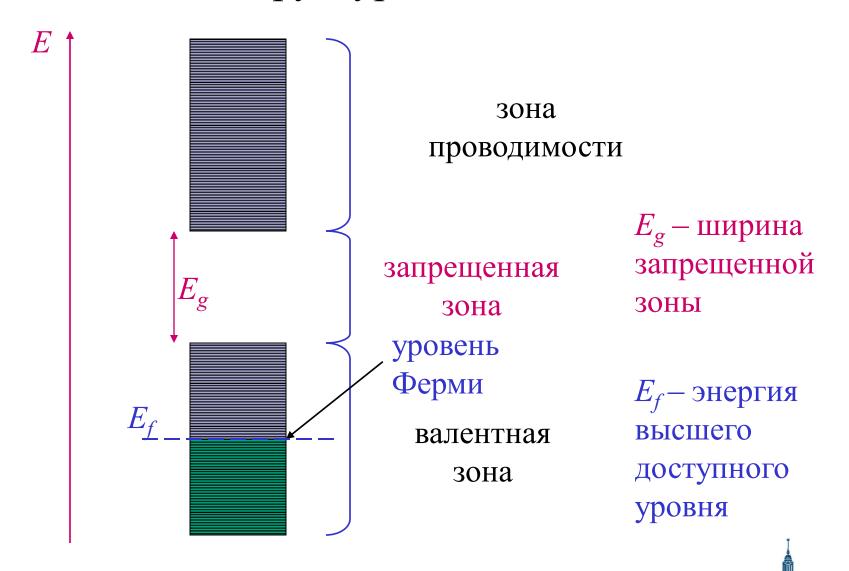
Зонная структура дает картину электронного строения твердого тела, позволяющую интерпретировать экспериментальные данные и делать прогнозы.



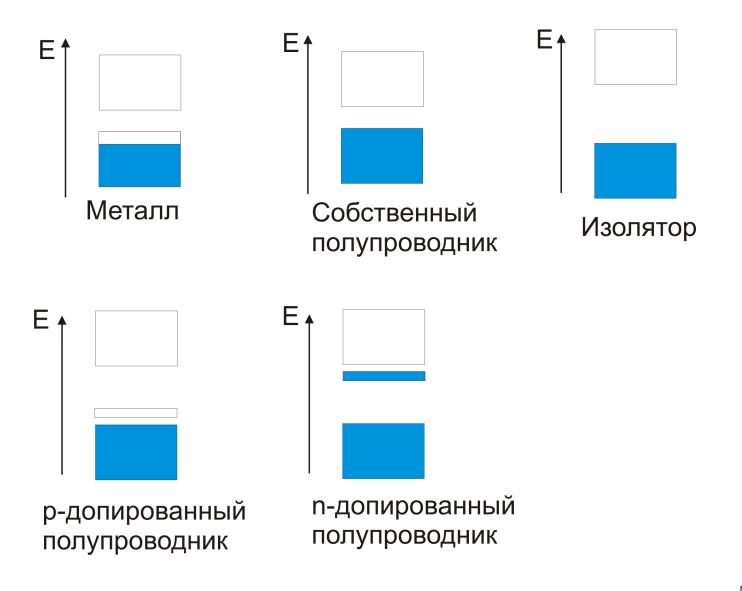
Кристаллические орбитали есть линейная комбинация атомных орбиталей во всей протяженности кристалла



Зонная структура лития: анализ



Металлы, полупроводники и изоляторы



Элементы подгруппы углерода

Элемент	$E_{g}(3B)$	Тип материала
С (алмаз)	6.0	ротятор
Si	1.1	полупроводник
Ge	0.7	полупроводник
Sn (серое олово)	0.1	полупроводник
Sn (белое олово)	0	металл
Pb	0	металл



Металлы, полупроводники и изоляторы

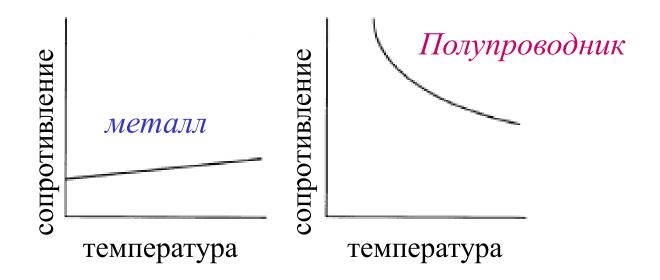
- 1. В ряду ПС слева направо увеличивается разница между энергиями s- и p-орбиталей
- 2. В группе ПС сверху вниз уменьшается разница между энергиями s- и p-орбиталей
- 3. Энергия s-орбиталей валентного уровня и энергия dорбиталей предыдущего уровня очень близки



- 1. Все неметаллы стремятся группироваться в верхнем правом углу ПС
- 2. Все переходные элементы металлы



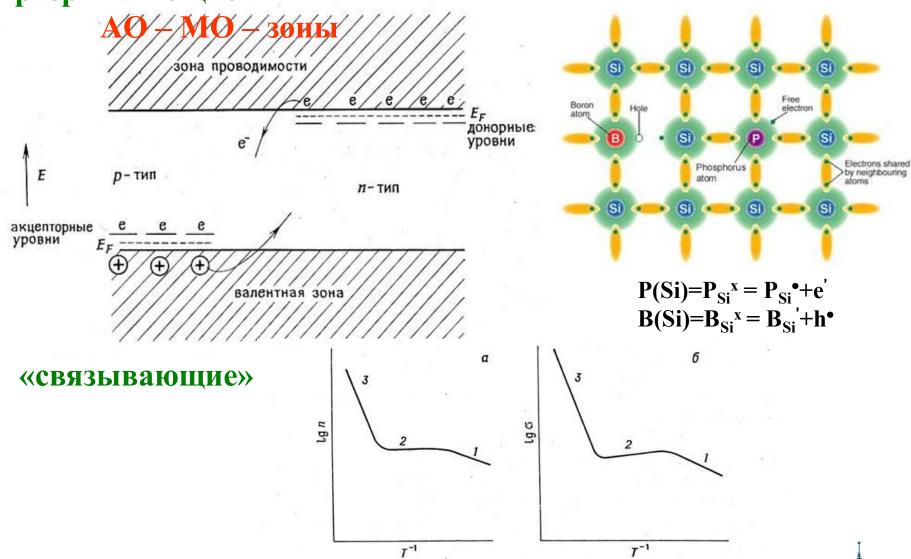
Сопротивление как функция температуры



- 1. Сопротивление металлов увеличивается при нагревании подвижность носителей уменьшается под действием колебаний решетки («фононы»)
- 2. Сопротивление полупроводников уменьшается при нагревании большее число носителей может перейти в зону проводимости

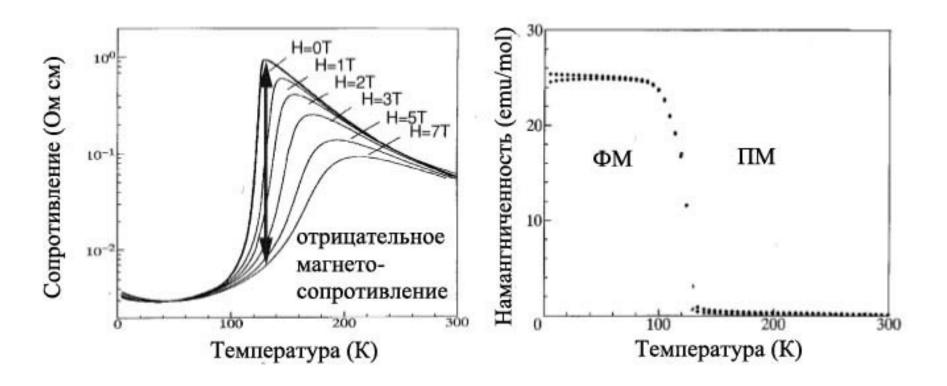
Легирование полупроводников

«разрыхляющие»



Температурные зависимости электропроводности (б) и концентрации носителей заряда (a) в полупроводниках. I — область примесной проводимости; 2 — область насыщения; 3 — область собственной проводимости.

Магнетосопротивление



MR = [R(0)-R(H)]/R(0),

где R(H) и R(0) — сопротивления при данной температуре в заданном и нулевом магнитных полях.



WSAAC

u36 pannue Hayruo. panmacmurecrue n pous be genus

"Кейворит"



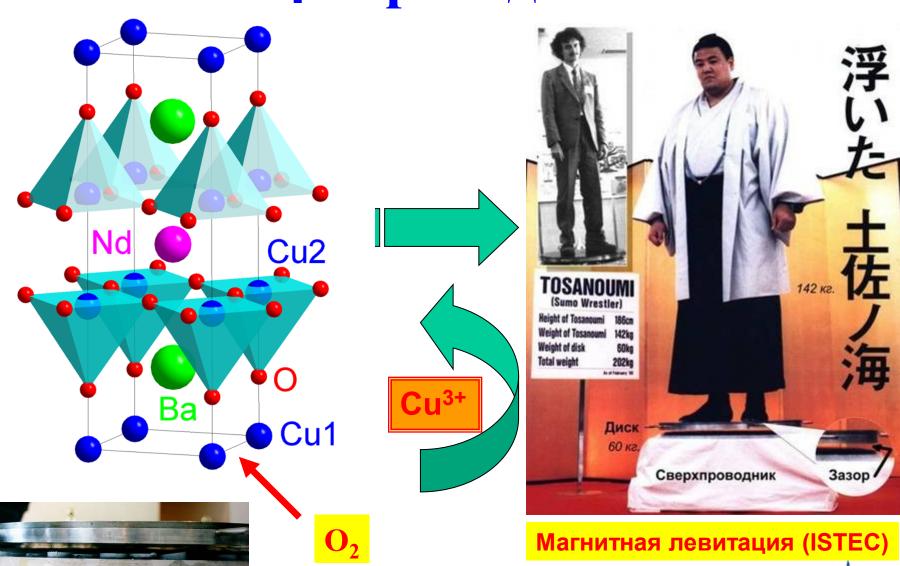


«Первые люди На Луне»

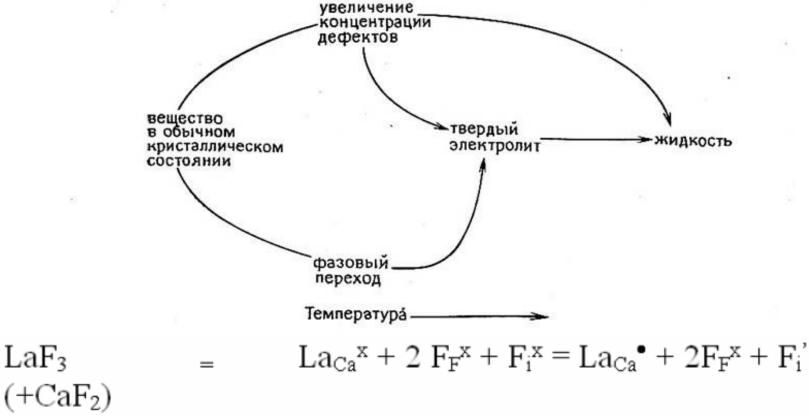


denuzdam. 1959

Сверхпроводимость



Особенности твердых электролитов



Отличие от жидких электролитов: твердые электролиты представляют собой вещества, промежуточные по структуре и свойствам между нормальными кристаллическими твердыми телами с регулярной трехмерной структурой, построенной из «неподвижных» атомов или ионов, и жидкими электролитами, не имеющими регулярной структуры, но обладающими подвижными ионами.

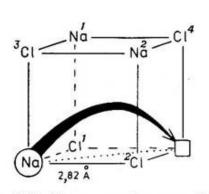


Рис. 13.3. Путь миграции иона Na+ в NaCl.

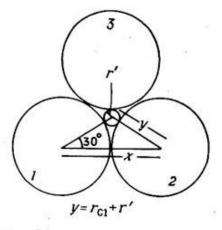
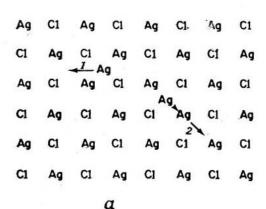


Рис. 13.4. Треугольное междоузлие, через которое должен проходить перемещающийся ион Na+ в NaCl. r'— радиус вписанной окружности; окружности 1—3 изображают ионы Cl- с радиусом x/2.

NaCl, дефекты по Шоттки



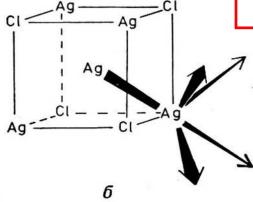
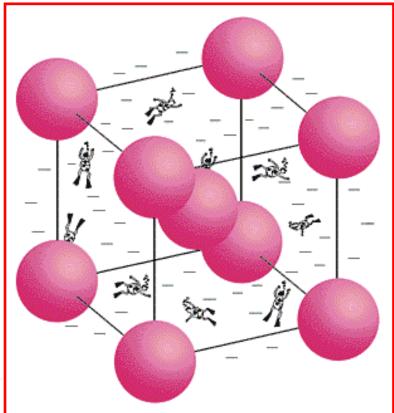


Рис. 13.6. Миграция межузельного иона Ag^+ : a — путем прямого перескока из одного междоузлия в другое (1) и с вытеснением регулярного иона в междоузлие (2); δ — возможные направления межузельной миграции иона Ag^+ в AgCl.

AgCl, дефекты по Френкелю

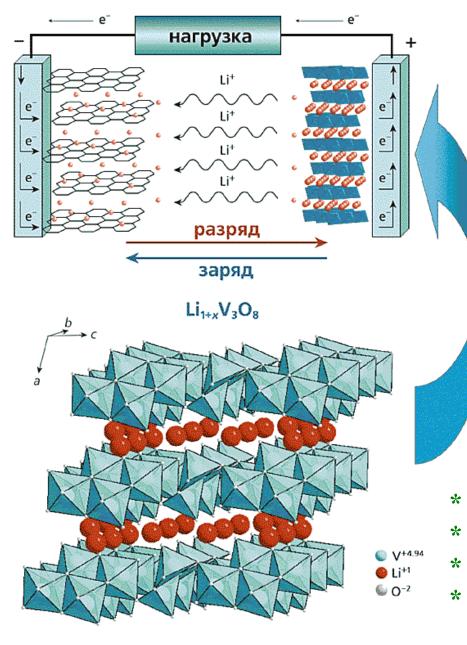


 $\Delta S_{\Pi \Pi}$ (NaCl)=24Дж/мол*К~ $\beta \rightarrow \alpha$ AgJ (14.5 Дж/моль*К, «плавление» подрешетки серебра) + α AgJ \rightarrow L (11.3 Дж/моль*К,

> Диффузия, миграция...

разупорядочнение Ј-)





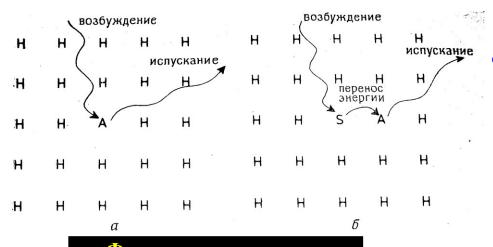
-Nа аккумуляторы
-кислородные сенсоры
-топливные ячейки
(кислород- и протонпроводящие твердые
электролиты для
водородной энергетики)

* 3d – элемент, смешанная ст.ок.

* Структурные плоскости, каналы

* Подвижные ионы Li⁺, «H⁺» (O²⁻, F⁻)

* Нестехиометрия



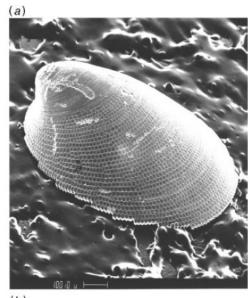
ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ a- в кристаллическую решетку основы Н введен активатор A; b- в кристаллическую решетку основы Н введены активатор A и сенсибилизатор S.

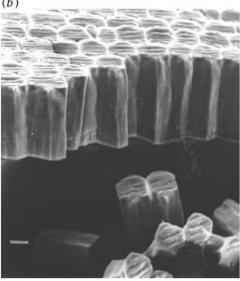
Электролюминесценция (дисплей іМас)





Биомиметика





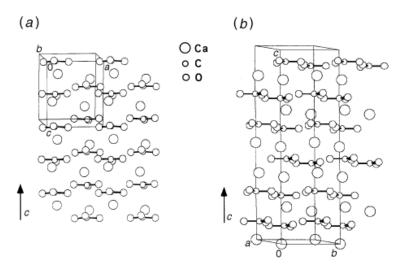


Fig. 3 Crystal structures of (a) aragonite and (b) calcite. Note that the c axis has been tilted out of plane by 5° to improve perspective.

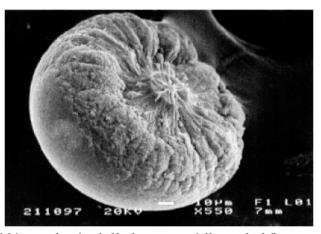
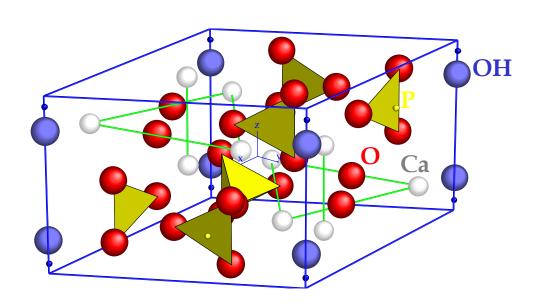


Fig. 4. SEM image showing half of an equatorially notched fluoroapatite-gelatine spheroid. Scale bar is 10 μ m. Reproduced with permission from *Chemistry of Materials* [30]. Copyright 2001 American Chemical Society.

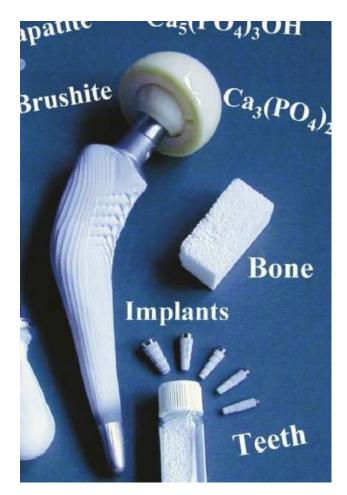


Биокерамика



 $P6_3/m$ a = 9.422 Å c = 6.880 Å

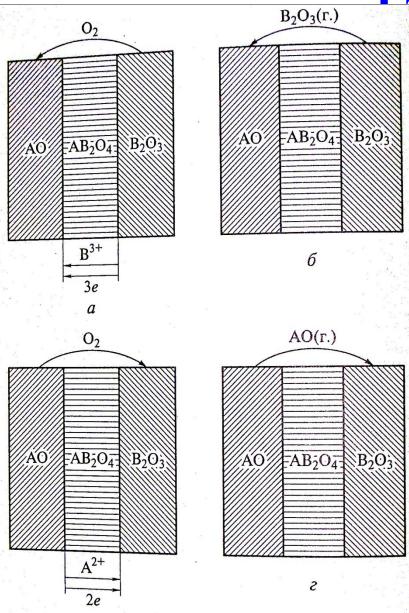
 $Ca_{10-x}(HPO_4)_x(PO_4)_{6-x}(OH)_{2-x}$



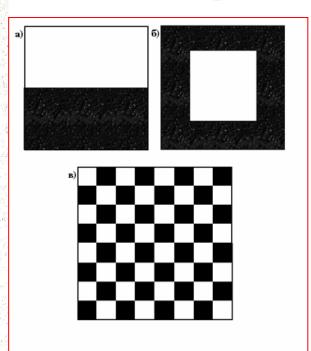
Изменение состава - биосовместимость



Кинетика твердофазных реакций _{В2О3(г.)}



Скорость ~ площадь



поверхности контакта (т)

форма поверхности

активность реагентов

соотношение диффузии и кинетики

-У3, сонохимия -микроволны -механохимия

-T, τ

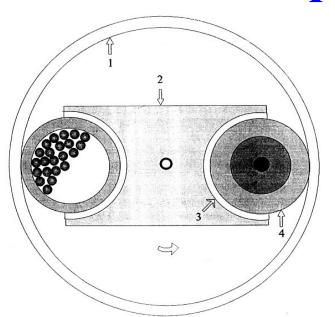




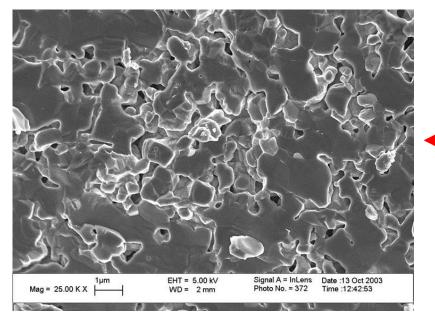
Кинетика твердофазных реакций отличается принципиально от кинетики химического взаимодействия отдельных атомов и молекул тем, что при твердофазных (гетерогенных) взаимодействиях в химическом превращении участвует огромное количество молекул и атомов, состсавляющих отдельные реагирующие друг с другом фазы. Поэтому в уравнения включается параметр площади контакта частиц вместо параметров соударения отдельных молекул в «обычной» кинетике химических реакций.



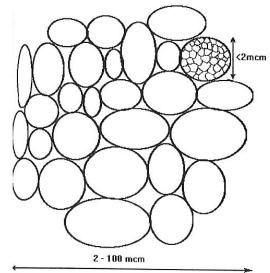
Помол-формование-спекание

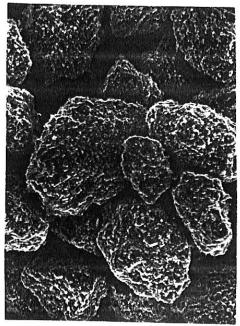


Мельница планетарного типа



(керамика)





Аагрегаты субмикронных частиц

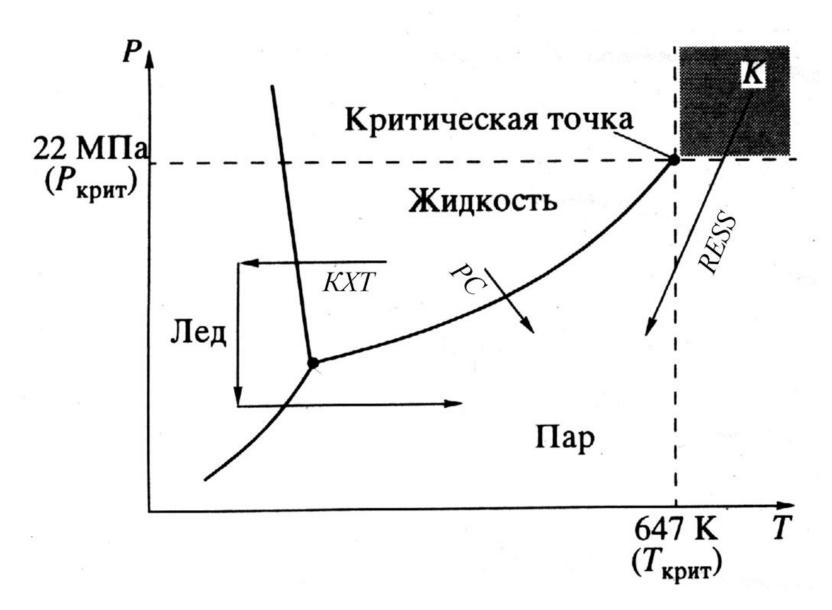
спекание

формование

«зерна»+перешейки+поры



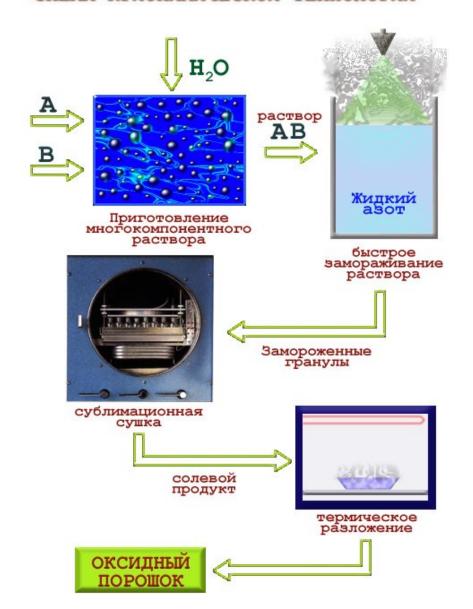
Методы химической гомогенизации

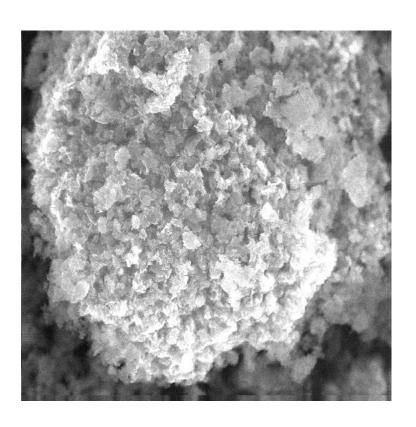




Сублимационная сушка

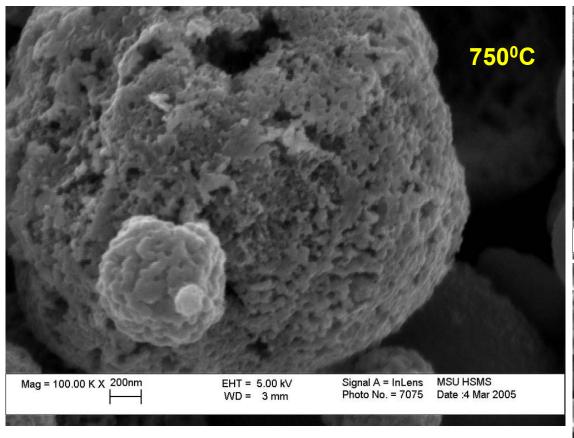
СХЕМА КРИОХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

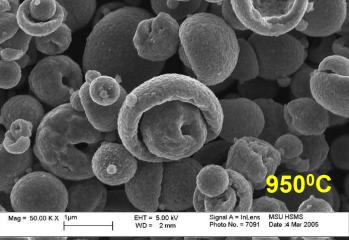


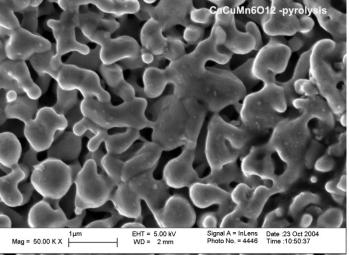


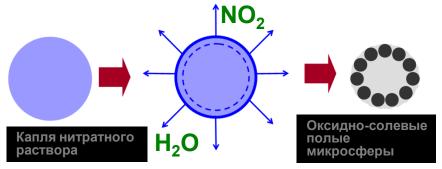


Пиролиз аэрозолей



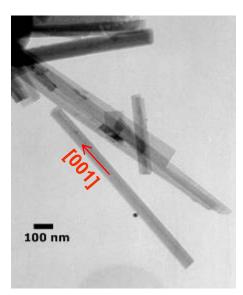


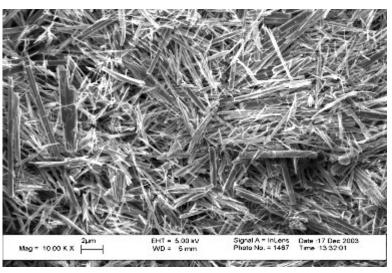






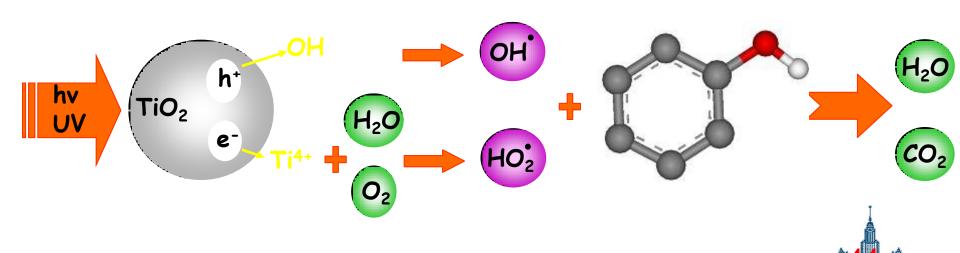
Гидротермальная обработка

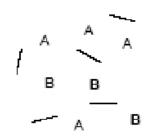




TiO₂,

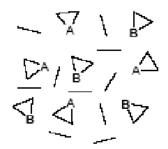
контроль рН вода 150-250°C



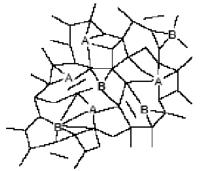


Золь-гель метод



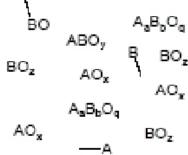


Образование хелатных комплексов металлов с многофункциональными органическими кислотами

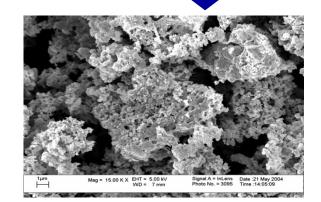


Реакция полимеризации с многоатомными спиртами

Термическое разложение

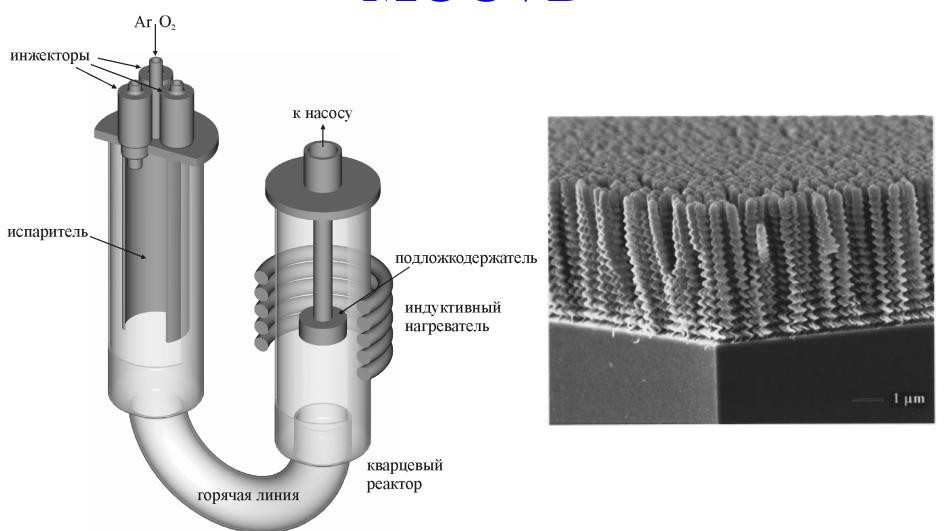


Получение материалов





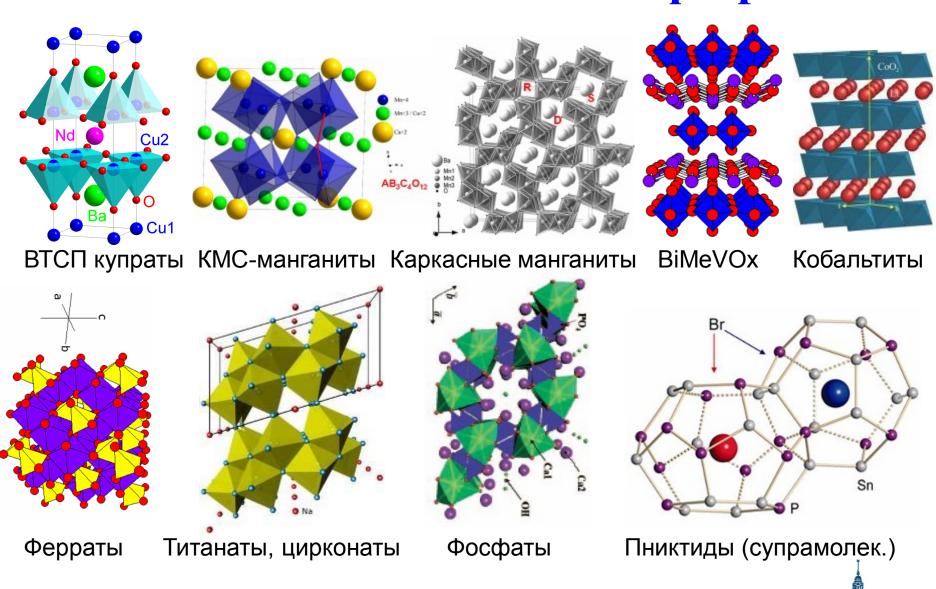
MOCVD



Осаждение из паровой фазы с использованием летучих металлорганических соединений



Сложные оксиды на кафедре



/

Заниматься наукой следует на кафедре неорганической химии уже с 1 курса. При всем многообразии выбор очевиден – современая химия на нашей кафедре.

Узнать больше о кафедре и выдающихся научных группах можно здесь:

http://www.inorg.chem.msu.ru/index_r.php



Основная литература

- А.Вест. Химия твердого тела. М.: Мир, 1988, т.1,2.
- Ю.Д.Третьяков, Х.Лепис. Химия и технология твердофазных материалов. М.: МГУ, 1985.
- О.Уайэтт, Д.Дью-Хьюз, Металлы. Керамики. Полимеры., М.: Атомиздат, 1979
- У.Д.Кингери. Введение в керамику. М.: Издво лит-ры по строительству, 1967, 494 с.

